This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04129745

PUBLICATION DATE

30-04-92

APPLICATION DATE

21-09-90

APPLICATION NUMBER

02252254

APPLICANT: SEIKO EPSON CORP:

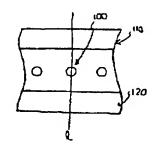
INVENTOR: ONO YOSHIHIRO;

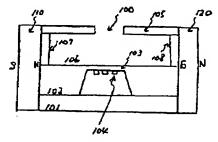
INT.CL.

B41J 2/045

TITLE

INK JET HEAD

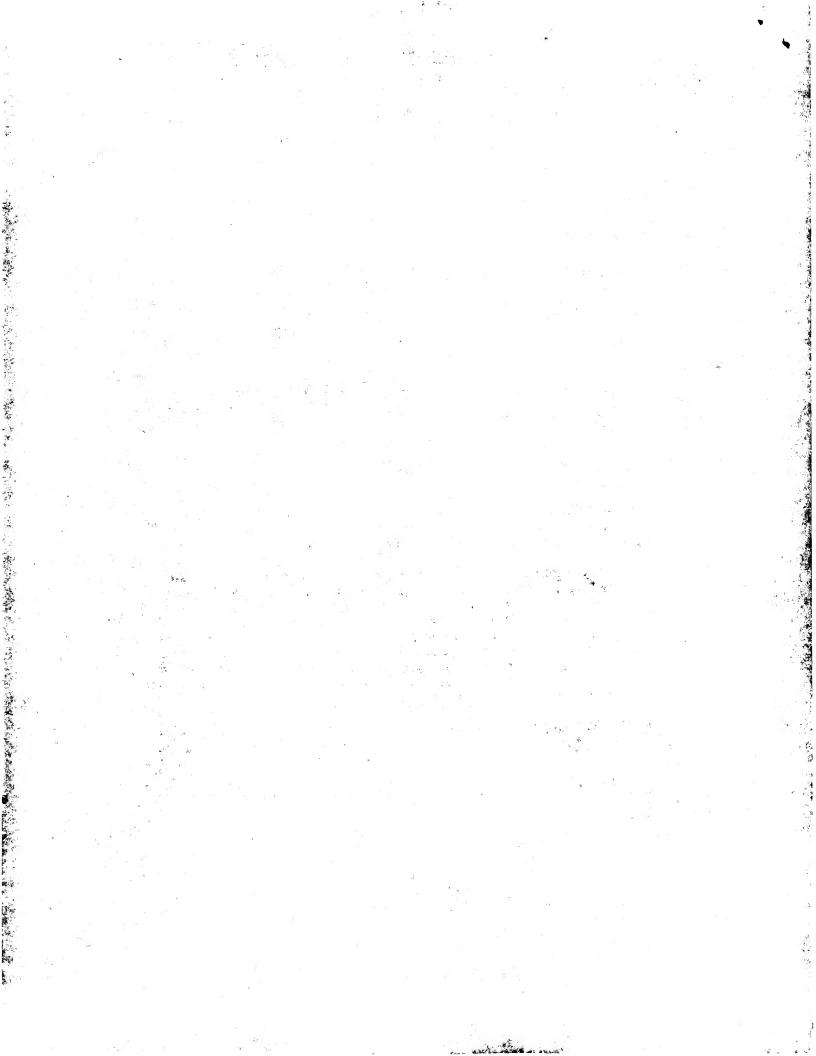




PURPOSE: To improve the life and printing quality (high density dot) by a method wherein a substrate which comes into contact with an ink has a diaphragm structure, and this diaphragm is displaced by magnetic force from the outside.

CONSTITUTION: Line of magnetic force which is generated by magnets 110, 120 arranged at both sides of an ink jet head goes across the inside of the ink jet head. At this time, electric current is charged in the wiring on a diaphragm 103, conforming to Fleming's rule, force is applied to the wiring 104, i.e., to the upper part or lower part of the diaphragm, in proportion to the strength of the line of magnetic force and the current value. The direction in which the force is applied is determined by the direction of the line of magnetic force and electric current, and by this force, the diaphragm is displaced, and pressure is added to the ink is surrounded by substrates 102 and 105, and the ink drop flies out from an ink discharge port 100.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio



19 日 本 国 特 許 庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

og i været en en et 🚓 🗙

四公開特許公報(A) 平4-129745

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内签理番号

❸公開 平成 4年(1992) 4月30日

B 41 J 2/045

9012-2C B 41 J 3/04

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

会発明の名称

インクジエツトヘッド

印特 願 平2-252254

②出 願 平2(1990)9月21日

個発明 者 大 野

好 弘

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

顧 人 @出 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

四代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

1. 発明の名称

インクジェットヘッド

2. 特許知求の范囲

- (1)インク106と扱する苔板102がダイヤ フラム桕道をもち、このダイヤフラムが外部から の力によって変位することによって、凸板102 と105によって囲まれている空間内に圧力変化 を生じさせ、犬100からインク106を吐出さ せることを特位とするインクジェットヘッド。
- (2) 箱求項 1 紀彼のインクジェットヘッドにお いて、ダイヤフラム103の変位を、インクジェ ットヘッドの左右の磁石からの磁力性とダイヤフ ラム上に形成された配約104の中を流れる包流 によって作られる力によって起されることを特徴 とするインクジェットヘッド。
- (3) 加求項1記成のインクジェットヘッドにお

ラムを基板101の方に引く力となるように配燈 104の中を官流が流れ、次いでその逆位性に 〇 流が流れることによりダイヤフラムの変位を詰板 105の方向へ起すことを傍位とするインクジェ ットヘッド.

3. 発明の詳細な説明

【意口上の利用分野】

本発明は、インク沿を飛翔させ記級戯体上に口 位を形成するインクジェット記憶のヘッドの构造 に関するものである。

〔従来の技術〕

インクジェットヘッドの保迫は罰々提及されて いるが、現在採用化されているのはインク内での 発盤体の偽発生によりインクの意発によるパブル 発生で圧力を生じさせる方式 (573回) とピェゾ 苧の圧包架子を凸板に取り付け、圧包架子の変形 を利用し凸板を変位させることによりインクタン ク内の圧力を変化させる方式(以4回)がある。

特閒平4-129745 (2)

ドの断面図であるが、蓋板301に発熱体302を形成し、インキの吐出穴を持った蓋板303を蓋板301に貼り付けることにより成るものでった。 発熱体は、スパッタ、CVD、蒸着、メルターの工程を提出し、フォトリソ・エッチング工程を目前は、フォトリソ・エッチングでを提出し、フォトリソ・エッチングでを提出している。 通電 中の での おる ことにより、インクション での 正力を変化させ、インク304を305の 大から吐出させるタイプのものである。

第4図は圧電素子方式のインクジェットへッドの断面図であるが、基板401にピエゾ等の圧電 素子を貼り付け、基板403と組み合わせるこことによりなるものである。圧電素子は一般にア・形成しまうなセラミックを焼成により形成し素子が成に切り出すことにより得られるこのインクシェットへッドの駆動は、圧電素子402に電圧をかけることにより、圧電素子をたわませると供に、基

いという欠点があった。

又、一方の圧電素子タイプは、発熱方式とは逆に上記のようなダメージがないためヘッド寿命は長いものの、圧電素子をセラミックブロックから切り出し、貼り付けるという工程からわかるように変動素子の高密度化が困難な構造となっている。

そこで本発明はこのような問題点を解決するもので、その目的は、変動素子の高密度化が可能でかつ寿命の長いインクジェットヘッドを提供するところにある。

[課題を解決するための手段]

本発明のインクジェットへッドはインク106 と接する基板102がダイヤフラム構造をもち、 このダイヤフラムが外部からの力によって変位す ることにより、基板102、105によって囲まれている空間内に圧力変化を生じさせ、大100 からインク106を吐出させることを特徴としている。

〔作 用〕

板 4 0 1 を同時にその力でたわませることにより、インクジェットヘッド内の圧力を変化させ、インク 4 0 4 を 4 0 5 の穴から吐出させるクィブのものである。

【発明が解決しようとする課題】

前述の発熱素子タイプ及び圧電素子タイプはそれぞれ長短を持っている。

発熱タイプは、ICプロセスのようないわゆる 薄膜プロセスによって駆動体となる発熱素子を形成できるため、駆動業子の高密度化は容易であ り、このため小型のインクジェットヘッドの中に 多くのインク吐出口を形成できるため、シリアル ヘッドの場合は高速でヘッドの移動が可能でかっ 高密度印字の可能なヘッドを形成することができ る、又、ラインヘッドの場合は高密度印字が可能 となる。

しかし、発熱方式によるため、加熱・急冷の繰り返しにより素子がダメージを受けること、及びインク中のパルブ消滅時の衝撃により発熱体がダメージを受けることによりヘッド自体の寿命が短

本発明の上記の構成を第1図- a) と第1図- b) に示す。第1図 a) は本発明のインクジェットヘッドをインクの吐出口100例の正面から見た図であり第1図 b) は本発明のインクジェットヘッドをライン&で切った断面図を示している。

本発明の上記の構成であれば、インクジェット ヘッドの両側に配された磁石により作られるの時、 線がインクジェットヘッド内を横切る。この時、 ダイヤフラム上の配線内に電流を流すと、フレミ ングの左手の法制に従い、磁力線の強さ、電流値 に比例して、配線104に、即ちダイヤフラムの 上方あるいは下方へ力が加わることになる。

力の加わる方向は、磁力線及び電流の方向によって決まり、これによってダイヤフラムが変位し基板 1 0 2 と 1 0 5 によって囲まれたインクに圧力が加わり、インキ吐出口 1 0 0 からインク滴が飛び出す。

次に実施例を用いて詳細に説明する。

[実施例1]

第1図(b)に本発明のインクジェットヘッド

の断面図を示すが、その製造プロセスは、

1)100段結品Si 基版を研磨により100μm以とし基版102とした低、Si 基板の片側から渡さ1μmにポロンを拡放した。このポロン拡放だは次工程でのエッチングストップ Dとなる。
2)Si 型板102のポロン拡放だと逆側に110方向へ1辺を合せ、1辺240μmの正方形の次を持つレジストパターンを形成し、80℃、30% 到底のKOH溶液に没和しSi のエッチングを行った。Si 基板は単結品であるため、KOHに対し結品方位によりエッチングスピードの足がある。即ち選択エッチング性があり、第2図に示す形状にエッチングされた。

3) 次に買1図b) ダイヤフラム部103に所定のパターンの配組104を形成した。 配組:04 は蒸谷によりAe 粒を2μmの厚さで形成した

役、配組104にフレミングの法則により力が吐出口100の方向へかかるように包流を流したところ、インク吐出口100からインク消を飛ばすことができた。

[突 筋 例 2]

[交 施 图 3]

双筋例1と同様の方法を用いて、 575 図の断面 似道をもつインクジェットヘッドを製道した。

双路例1の製造プロセスにおいて、ダイヤフラム 節503に所定のパターンを持った包括504を形成した役、この関題上にSiO。 即を3000人形成してインクとの絶い化処理を行った。

このインクジェットヘッドは契施例1と同様の 方法により吐出口よりインク級を飛ばすことがで 後、通常のフォトリソエッチング工程をへて所定 のパターンを形成した。

- 5) 夏に直径50μmのインク吐出口106を持つ口さ50μmのノズルブレート 芸板105を弦板102との間隔が800μmとなるようにスペーサー107と108を入れエポキシ樹脂を用いて貼り合わせた。
- 6) このようにして組み立てられたインクジェットへッドの両例に永久旺石110、120を昇1 図に示すように田松を配配することにより本発明のインクジェットヘッドを作った。
- 7) 芸板102と105の間にインクを渦たした

8 t.

【発明の効果】

以上変施例よりわかるように、本発明のインクジェットヘッドは、短助に発照方式を取らないため呆子の身命が長く、かつ駆助案子がICプロセスに代表される刃削加工プロセスにより形成されるため駆助案子の高密度化が可能である。

即ち、本発明によれば西切命かつ高田字品質 (高密度ドット)のインクジェットヘッドが可能 となった。

4. 図面の簡単な説明

到 1 図 (a) は本発明のインクジェットヘッドの上面図、以 1 図 (b) は本発明のインクジェットヘッドの断面図。

37 2 図は本発明のインクジェットヘッドダイヤフラム 邸の断面形状図。

第3図は従来の発熱式インクジェットヘッドの 断面図。

第4回は従来の圧電景子式インクジェットへっ

特閒平4-129745 (4)

ドの断面図。

第5図は本発明のインクジェットヘッドの断面 図。

- 100・・・インク吐出口(ノズル)
- 101・・・パイレックス基板
- 102···Si蓋板
- 103・・・ダイヤフラム部
- 104 · · · 空線
- 105・・・ノズルブレート
- 106 · · · 液晶
- 108・・・スペーサー
- 110 · · · 雖石
- 120 · · · 磁石
- 301・・・基板
- 302 - ・ 発熱体
- 303・・・ノズルブレート
- 305・・・ノズル (インク吐出口)

401. · · 基板

402 · · · 庄電素子

403・・・ノズルブレート

405・・・ノズル(インク吐出口)

500・・・ノズル

501・・・パイレックスガラス基板

5 0 2 · · · S i 基板

503・・・ダイヤフラム部

504 · · · 配線

505・・・ノズルブレート

506 · · · 液晶

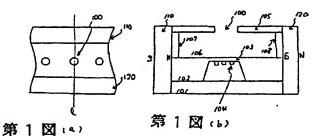
508・・・スペーサー

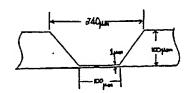
509···艳珠旗(SiO₃)

5 1 0 · · · 磁石

5 2 0 · · · 班石

以上





第2图

